

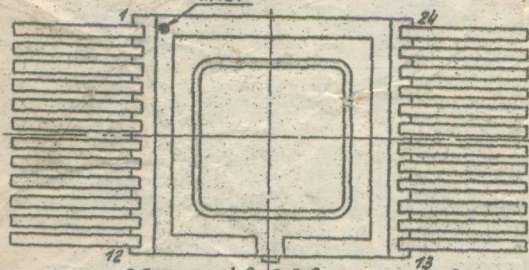
Этикетка

Подупробо́дничо́вая интегральная микросхема 537РУ9 - оператив-
ное запоминающее устройство (статическое).

Климатическое исполнение: В.

Схема расположения выводов

Ключ



Обозначение выводов показано условно

Таблица назначения выводов

номер вывода	обозна- чение	наименование вывода
1	A7	Вход адресный строки
2	A6	Вход адресный строки
3	A5	Вход адресный строки
4	A4	Вход адресный строки
5	A3	Вход адресный столбца
6	A2	Вход адресный столбца
7	A1	Вход адресный столбца
8	A0	Вход адресный столбца
9	D1 00	Вход (выход) нулевого разряда данных
10	D1 01	Вход (выход) первого разряда данных
11	D1 02	Вход (выход) второго разряда данных
12	0V	Общий вывод
13	D1 03	Вход (выход) третьего разряда данных
14	D1 04	Вход (выход) четвертого разряда данных
15	D1 05	Вход (выход) пятого разряда данных
16	D1 06	Вход (выход) шестого разряда данных
17	D1 07	Вход (выход) седьмого разряда данных
18	EE	Вход сигнала разрешения
19	A10	Вход адресный строки
20	DE	Вход сигнала разрешения выхода
21	WR/RD	Вход сигнала записи/считывания
22	A9	Вход адресный строки
23	A8	Вход адресный строки
24	V	Вывод питания от источника напряжения

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °C
		537py9A	537py9B	537py9A	537py9B	
		не менее	не более	не менее	не более	
Выходное напряжение низкого уровня, В <i>при: $I_{out}=1,7mA$ $R_L \geq 10k\Omega$</i>	U_{out}	—	0,3	—	0,3	25 ± 10
		—	0,4	—	0,4	-60, 85, 125
		—	0,05	—	0,05	25 ± 10
		—	0,1	—	0,1	-60, 85, 125
Выходное напряжение Высокого уровня, В <i>при $I_{out}=12mA$ $R_L \geq 10k\Omega$</i>	U_{OH}	2,6	—	2,6	—	25 ± 10
		2,4	—	2,4	—	-60, 85, 125
		$U_{LH} \geq 0,95$	—	$U_{LH} \geq 0,95$	—	25 ± 10
		$U_{LH} \geq 0,18$	—	$U_{LH} \geq 0,18$	—	-60, 85, 125
Напряжение питания Режим хранения	U_{ccs}	—	3	—	3	25 ± 10
		—	3,3	—	3,3	-60, 85, 125
Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	—	0,4	—	0,4	25 ± 10 , -60, 85, 125
Входное напряжение Высокого уровня, В	U_{IH}	4,0	—	4,0	—	25 ± 10 , -60, 85, 125

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма				Темпе- ратура, °C
		537ру9А		537ру9Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Ток потребле- ния в режиме $U_{ce}=5,5В$ хранения, мА при $U_{ce}=3,3В$	I_{ces}	—	0,2	—	0,5	25 ± 10
			1,0		2,0	$-60,$ $85, 125$
		—	0,12	—	0,3	25 ± 10
			0,6		1,2	$-60,$ $85, 125$
Ток потребления, мА при $U_{ce} = \text{лог. "0"}$	I_{cc}	—	35	—	35	$25 \pm 10,$
			50		50	$-60,$ $85, 125$
Ток утечки низкого и высокого уровня на Входе, мкА	I_{LH}	—	3	—	3	25 ± 10
	I_{LH}		10		10	$-60,$ $85, 125$
Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии „выключено“, мкА	I_{OZH}	—	3	—	3	25 ± 10
	I_{OZH}		10		10	$-60,$ $85, 125$
Время выборки разрешения, нс	$t_{A(CE)}$		190		320	25 ± 10
			220		400	-60
			270		400	$85, 125$
Время цикла записи (считывания), нс	$t_{cy(WR)}$		350		500	25 ± 10
	$t_{cy(RD)}$		400		580	$-60,$ $85, 125$

продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °C
		537P49A		537P49B		
		не менее	не более	не менее	не более	
Время выборки адреса, нс	$t_A(A)$	—	210	—	340	25 ± 10
			240		420	$-60, 85$
			290		420	125
Время установления сигнала разрешения после сигнала адреса, нс	$t_{su}(A-CE)$	—	20	—	20	$25 \pm 10, -60, 85, 125$
Время установления сигнала записи после сигнала входной информации	$t_{su}(DI-WR)$	—	0	—	0	$25 \pm 10, -60, 85, 125$
Время выборки сигнала разрешения выхода, нс	$t_A(OE)$	—	70	—	70	25 ± 10
			100		100	$-60, 85, 125$
Время установления сигнала разрешения после сигнала считывания, нс	$t_{su}(RD-CE)$	—	20	—	20	$25 \pm 10, -60, 85, 125$
Длительность сигнала записи, нс	$t_W(WR)$	—	210	—	340	25 ± 10
			240		420	$-60, 85$
			290		420	125

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма				Температура, °C
		537py9A		537py96		
Длительность сигнала разрешения, нс	$t_w(CE, A)$	—	190 220 270	—	320 400 400	25 ± 10 -60, 85, ~~125~~
Время сохранения сигнала входной информации после сигнала записи, нс	$t_y(WR-2T)$	—	50	—	50	25 ± 10 , -60, 85, ~~125~~
Время сохранения выходной информации после сигнала разрешения выхода, нс	$t_y(OE-2D)$	—	290 390	—	290 390	25 ± 10 -60, 85, ~~125~~
Время сохранения сигнала адреса после сигнала разрешения, нс	$t_y(CE, H-A)$	—	160	—	160	25 ± 10 , -60, 85, ~~125~~
Емкость Входа/Выхода, пф	$C_{I/O}$	—	14	—	14	25 ± 10
Входная емкость по Выводам: $AQ-A10$; $CE, WR/RD, OE$ пф	C_I	—		—		

Допускается букву А не маркировать,
Вместо буквы Б наносить „в“

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото 23,2527 г.

серебро 50,1764 г.

Золото 0,00006502 г/мм на выводе длиной 1 мм.
Сведения о приемке

Микросхема интегральная 531РУ9 соответствует техническим
условиям 0.347.243-09ТУ.

Приняты по извещению №

106

от

24/х/

Место для
штампа ОТК

ОТК-21

Место для штампа
представителя-заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Приняты по извещению №

от

(дата)

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя-заказчика

134406